

【1000 ~ 2000万円】SiC/IGBT Power Device Process Integration Expert

外資系デバイスメーカーでの募集です。 電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓...

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
外資系デバイスメーカー

求人ID
1586992

業種
通信・キャリア

会社の種類
外資系企業

雇用形態
正社員

勤務地
大阪府

給与
1000万円 ~ 2000万円

勤務時間
09:00 ~ 18:00

休日・休暇
詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

更新日
2026年10月31日 07:00

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2224782】
・SiC/IGBTパワー半導体プロセスインテグレーション構築を担当していただきます。
・部分工程であるプロセスモジュールインテグレーションの構築を進めていただきます。
・業界に先んじて最先端、高性能かつ高信頼な競争力の高いパワーデバイスの研究開発にプロセスインテグレーターとして貢献していただきます。
・最新のパワー半導体製造プロセスを調査・研究し、開発テーマを提案していただきます。
・プロセス設備導入に際して、設備選定等に助言をいただきます。

・革新的で競争力のあるプロセスプラットフォームを構築していただきます。

スキル・資格

・おおよそ20年以上の半導体またはそのプロセス技術の研究・開発・製造における経験を持ち、SiC/IGBTプロセスインテグレーション開発業務に精通している。
・プロセスシミュレータに精通し、高性能SiC/IGBTパワー半導体プロセス開発を推進できる。
・半導体新工場の建設、設備選定、導入などのプロセスに精通している。
・半導体プロセス技術開発、プロセス設備開発、プロセス設備選定、開発ラインまたは生産ライン立ち上げ経験などの経験を持つ。
・生産現場における技術的ボトルネック改善や良品率向上などの課題解決の経験を持つ。
・最新のSiC/IGBTパワー半導体プロセス技術に詳しく、学会や業界に対し広い人脈を持つ。
・優れた学習能力、問題解決能力、コミュニケーション能力、職業倫理及びチームワーク精神を持っていること。
・海外出張に対応可能であること。基本的な英語のコミュニケーション能力とリーディング、ライティングスキルを有すること。

会社説明

ご紹介時にご案内いたします